





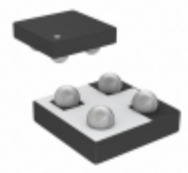
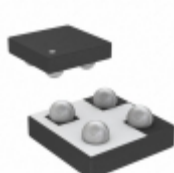



	<p><b>SI8405DB-T1-E1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8405DB-T1-E1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8405DB-T1-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3070 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8405DB-T1-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3070 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	950mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8405DB-T1-E1 ist neu im Original, Suche SI8405DB-T1-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8405DB-T1-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8405DB-T1-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8405AB-B-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV 4CH I2C 16SOIC</p>	 <p><b>SI8405DB</b> VISHAY SI8405DB VISHAY</p>	 <p><b>SI8405DB-T1</b> VISHAY SI8405DB-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI8405DB-T1-E3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP</p>
 <p><b>SI8405DB-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p><b>SI8405AB-B-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV 4CH I2C 16SOIC</p>	 <p><b>SI8406DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 16A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8406DB-T2-E1</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 20V 16A MICROFOOT</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ SI8261BAC-C-IS	↔ SI8261BAD-C-IS	⇒ SI8261BBC-C-IS	D SI8261BBD-C-IS	↔ SI8261BCC-C-IP
⊣ SI8261BCC-C-IS	⊗ SI8261BCD-C-IS	D SI8388P-IU	⇒ SI8400AA-B-IS	↔ SI8400AB-B-ISR
⊗ SI8401DB-T1	⊣ SI8401DB-T1-E1	⊗ SI8401DB-T1-E1	↔ SI8401DB-T1-E3	↔ SI8401DB-T1-E3
D SI8402DB-T1	⊗ SI8402DB-T1-E1	⊣ SI8402DB-T1-E1	⊗ SI8402DB-T1-E1.	↔ SI8402DB-T1-E3
⇒ SI8404DB-T1-E1	↔ SI8404DB-T1-E1	⊗ SI8405DB	⊣ SI8405DB-T1	↔ SI8405DB-T1-E1
↔ SI8405DB-T1-E3	⇒ SI8405DB-T1-E3	D SI8409DB-T1	⊗ SI8409DB-T1-E1	⊣ SI8409DB-T1-E1
⊗ SI8410AB	D SI8410BB-D-ISR	⇒ SI8410BB-I-DS	↔ SI8413DB-T1-E1	↔ SI8413DB-T1-E1
⊣ SI8415DB-T1	⊗ SI8415DB-T1-E1	↔ SI8415DB-T1-E1	⇒ SI8417DB-T2-E1	↔ SI8417DB-T2-E1
⊗ SI8420BB	⊣ SI8420BB-D-IS	⊗ SI8421AB-D-ISR	D SI8422AB-D-ISR	↔ SI8422BD
↔ SI8424DB-T1-E1	⊗ SI8424DB-T1-E1	⊣ SI8425DB-T1-E1	⊗ SI8425DB-T1-E1	↔ SI8429DB-T1-E1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited